

	<h2 style="color: red;">FDP030N06B-F102</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP030N06B-F102</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 120A TO-220-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDP030N06B-F102.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP030N06B-F102
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	205W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	FDP030N06B_F102
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8030pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	99nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 120A (Tc) 205W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDP030N06B-F102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDP030N06B-F102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDP030N06B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDP030N06B-F102 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDP030N06B FAIRCHILD FDP030N06B FAIRCHILD</p>	 <p>FDP027N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP032N06 FAIRCHILD FDP032N06 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP032N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A TO-220</p>
 <p>FDP030N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO220</p>	 <p>FDP030N06B_F102 Fairchild/ON Semiconductor FDP030N06B_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDP030N06BTU FAIRCHILD FDP030N06BTU FAIRCHILD</p>	 <p>FDP027N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A TO-220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDP030N06B-F102 AMI Semiconductor	FDP030N06B-F102 Datenblatt	FDP030N06B-F102-Datenblätter	FDP030N06B-F102 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDP030N06B-F102
FDP030N06B-F102 Electronic	FDP030N06B-F102-Komponenten	FDP030N06B-F102-Verteiler	FDP030N06B-F102-Bild	FDP030N06B-F102-Teil
FDP030N06B-F102 Preis	FDP030N06B-F102 Hersteller	FDP030N06B-F102 Bild	FDP030N06B-F102 Aktie	FDP030N06B-F102 Inventar
FDP030N06B-F102 Neu	FDP030N06B-F102 Original	FDP030N06B-F102 garantiert	FDP030N06B-F102 RFQ	FDP030N06B-F102 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited